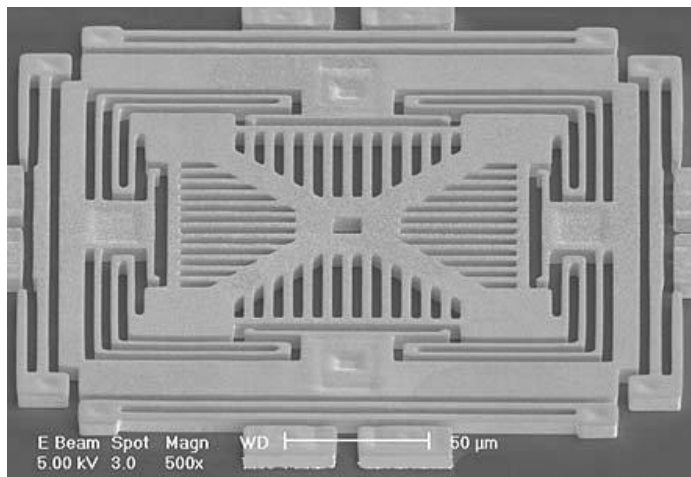


МЭМС

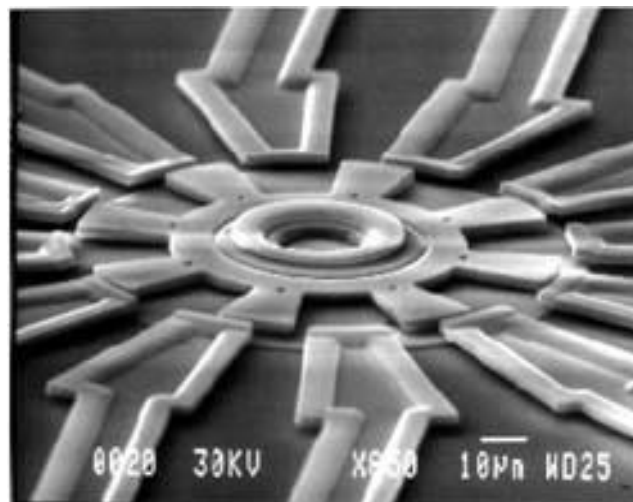
Микроэлектромеханические системы

Что такое МЭМС?

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) – это системы, включающие в себя взаимосвязанные механические и электрические компоненты микронных размеров.



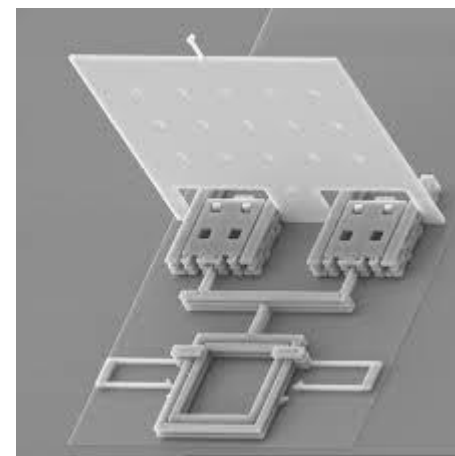
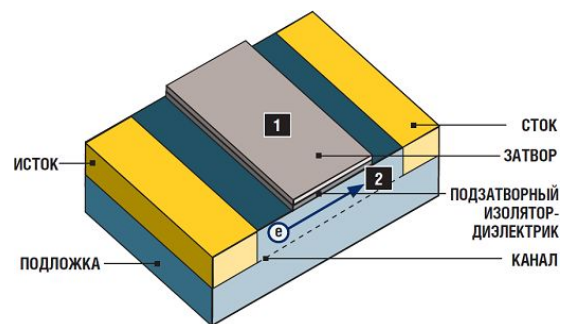
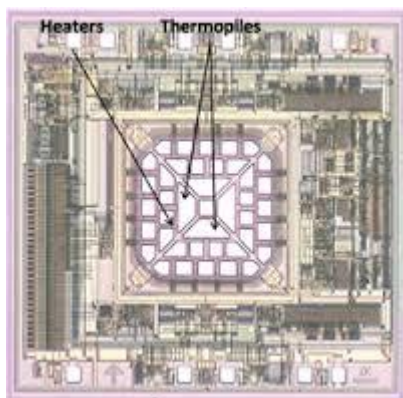
*Трехосевой
акселерометр*



*Электрический
микродвигатель*

Что такое МЭМС?

МЭМС = Электроника + Микромеханика



История создания

1958 г. - первые прототипы интегральных схем (ИС);

1960 г. - мелкосерийный выпуск ИС;

1974 г. - промышленный выпуск тензодатчиков на основе кремния (National Semiconductors);

1982 г. - термин микрообработка (micromachining) используется для описания процессов изготовления механических подсистем (диафрагм и микробалок);

1986 г. - в одном из отчетов министерства обороны США был впервые использован термин

“микроэлектромеханические системы” (МЭМС);

Способы изготовления

Изготовление МЭМС



Объемная
микрообработка
(bulk micromachining)

Субтрактивный подход – от
целого отсекаем лишнее
(как изготовление статуи)

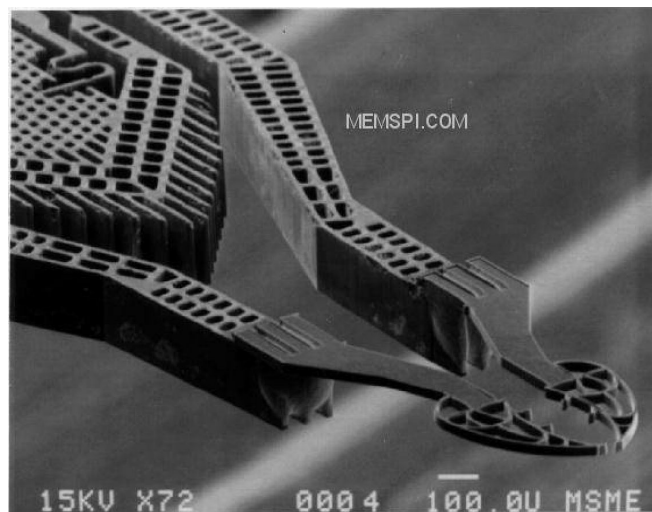


Поверхностная
микрообработка
(surface micromachining)

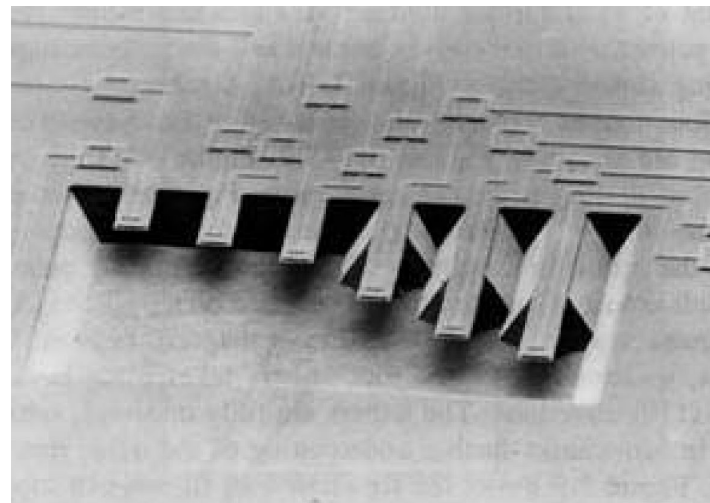
Аддитивный подход –
строим целое из
кирпичиков
(как строительство дома)

Объемная микрообработка

Это процесс, идущий от поверхности материала-основы вглубь, при которой травлением последовательно удаляются ненужные участки этого материала, в результате чего остаются механические структуры необходимой формы.

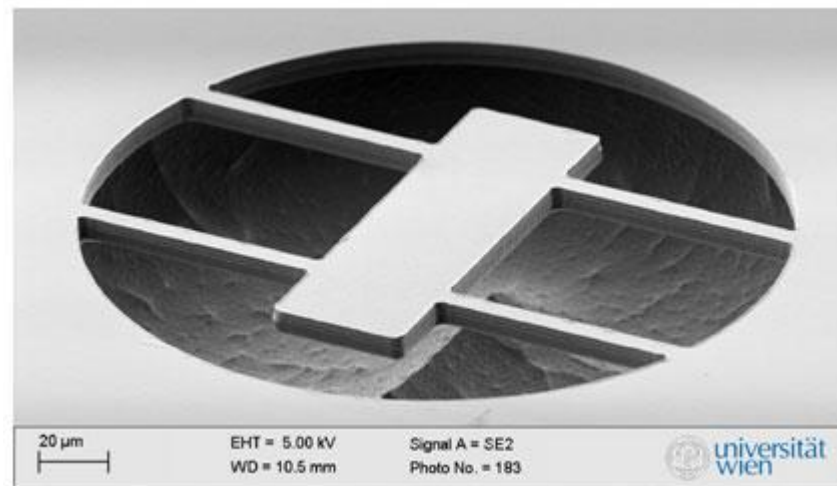
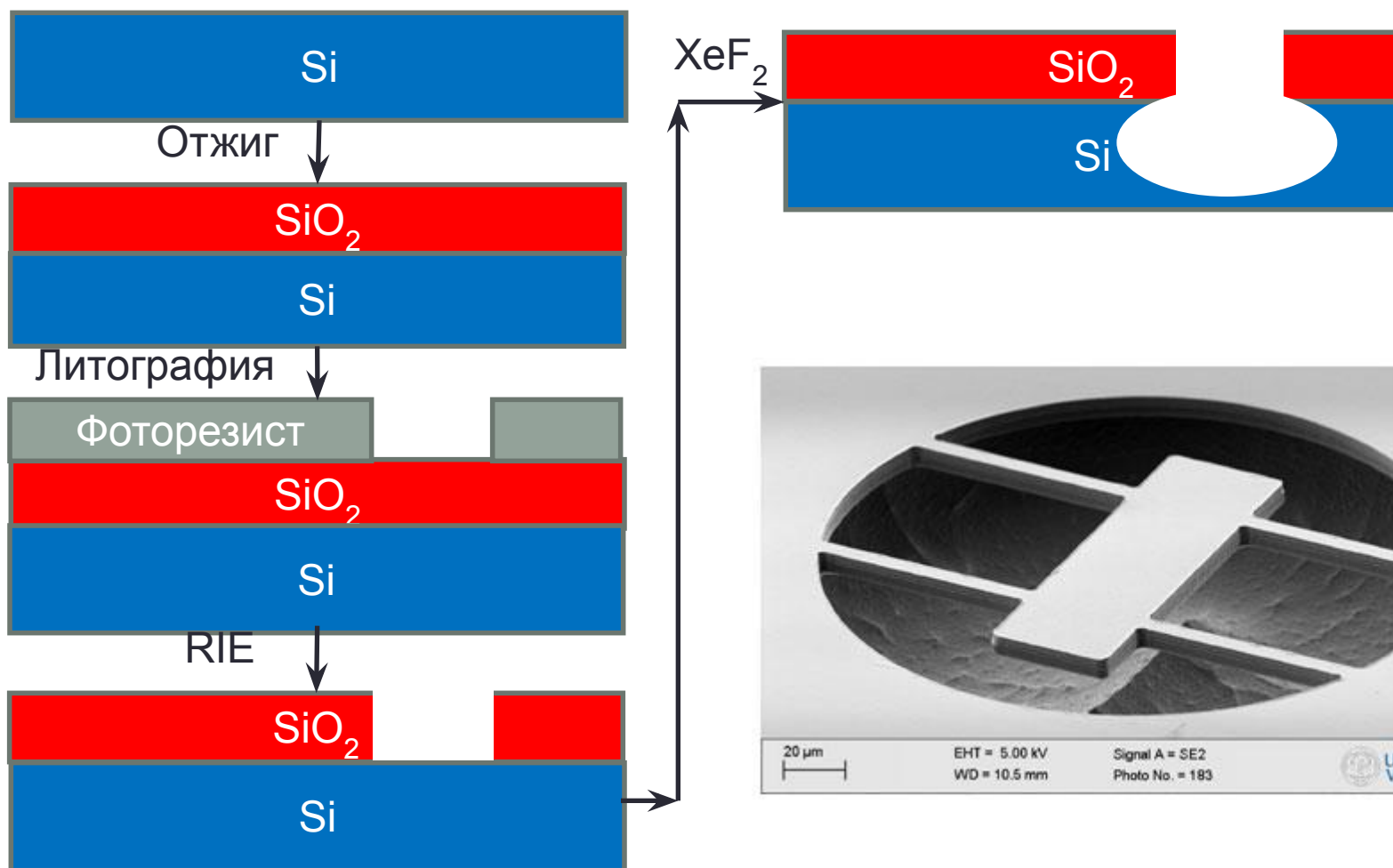


Микрозахват (microgripper)



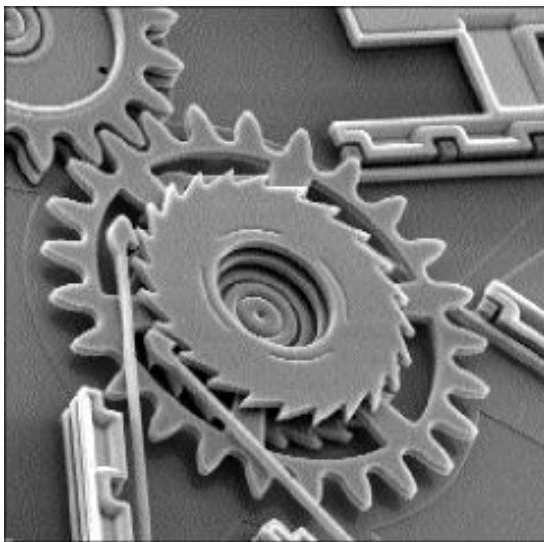
Микрокантилеверы

Объемная микрообработка

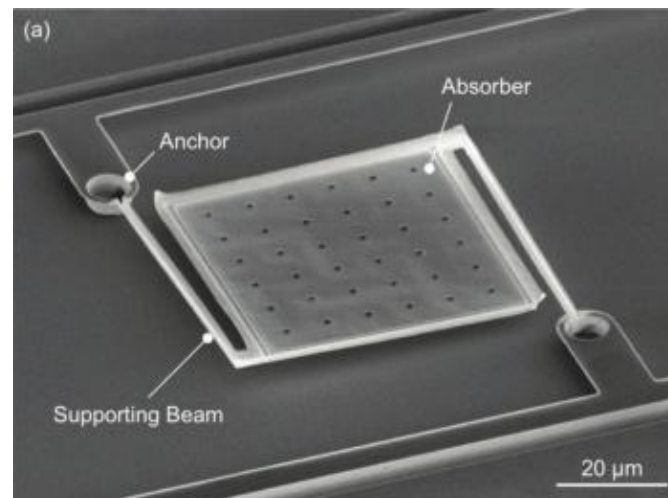


Поверхностная микрообработка

Это процесс, заключающийся в последовательных циклах нанесения тонких слоев материала, которые затем с помощью литографии и последующего травления приобретает необходимую геометрическую форму

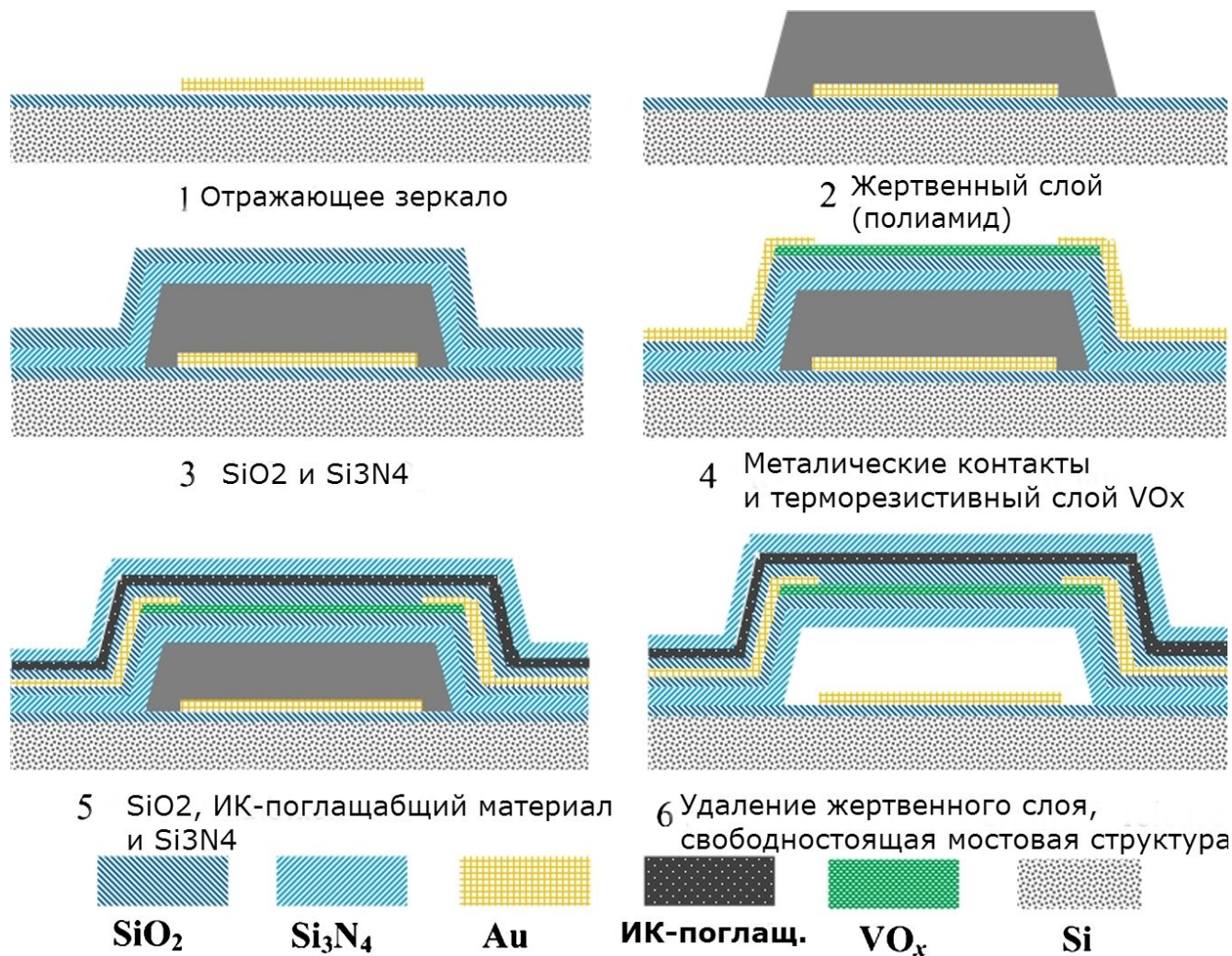


Система зубчатой передачи

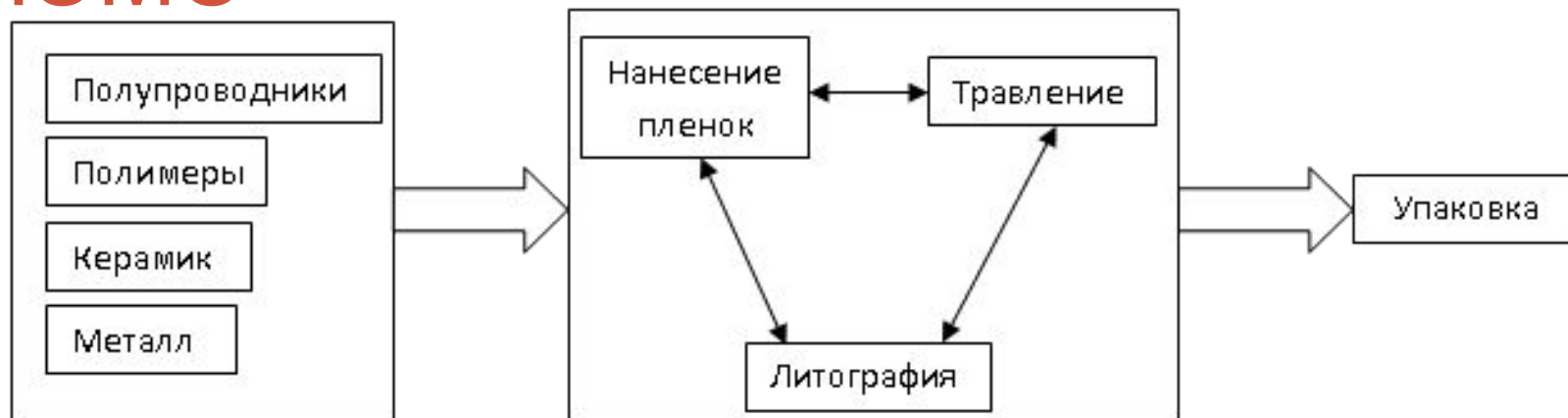


*Элемент
тепловизионной
матрицы*

Поверхностная микрообработка



Обобщенная схема изготовления МЭМС



Применение МЭМС

```
graph TD; A[Применение МЭМС] --> B[Датчики:]; A --> C[Исполнительные механизмы (актуаторы):];
```

Датчики:

Акселерометры;
Гироскопы;
Магнетометры;
Датчики давления
расходомеры

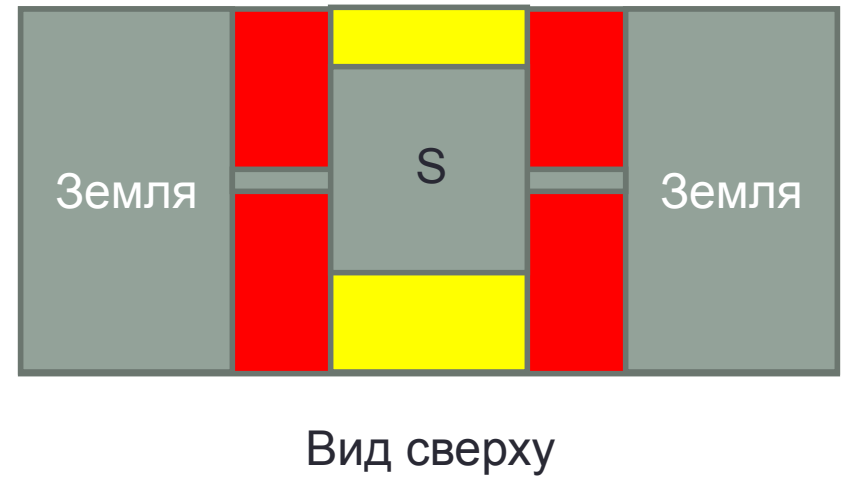
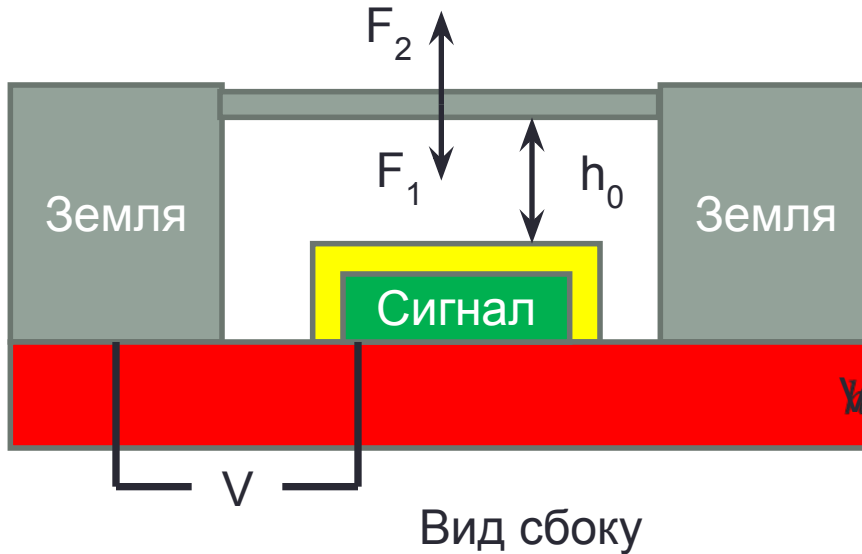
Исполнительные
механизмы (актуаторы):

Микродвигатели;
Микрозахваты;
Микрозеркала;

Области применения:

1. МЭМС-компоненты для высокочастотной электроники (RF MEMS);
2. Датчики на основе сил инерции;
3. Акустические и ультразвуковые МЭМС, датчики давления;
4. Оптические МЭМС;
5. Биомедицинские МЭМС;
6. Микроманипуляторы.

Высокочастотные МЭМС ключи



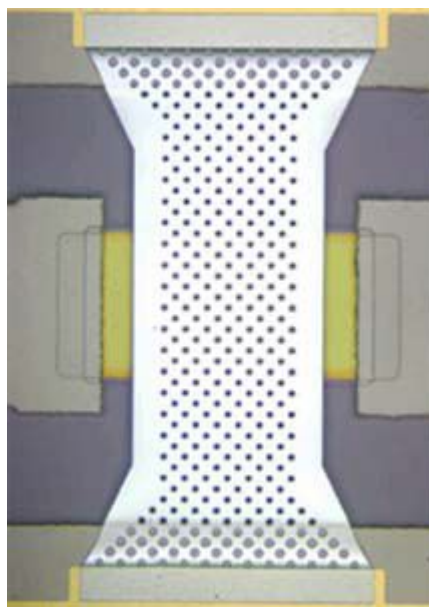
$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

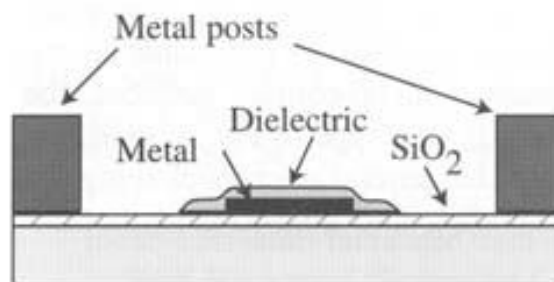
$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора) \rightarrow $\frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора) $\rightarrow V' = 0 \rightarrow F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора) $\rightarrow \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

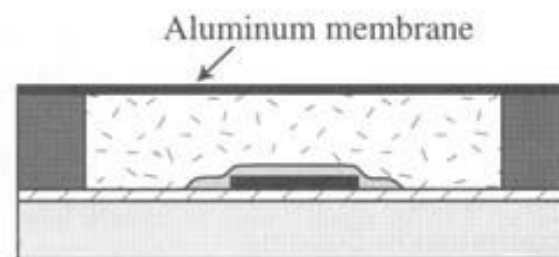
Высокочастотные МЭМС ключи



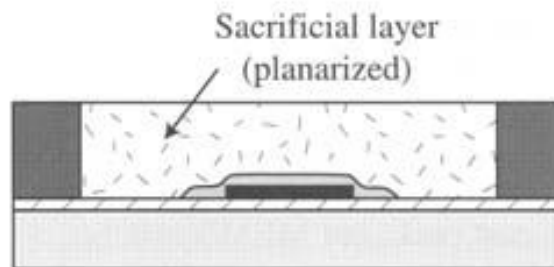
$$V_{кр} = 30-50В$$



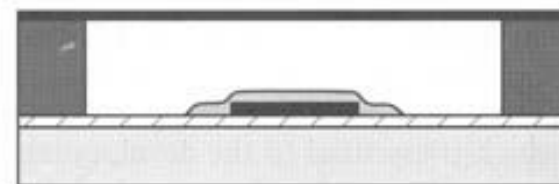
(a)



(c)

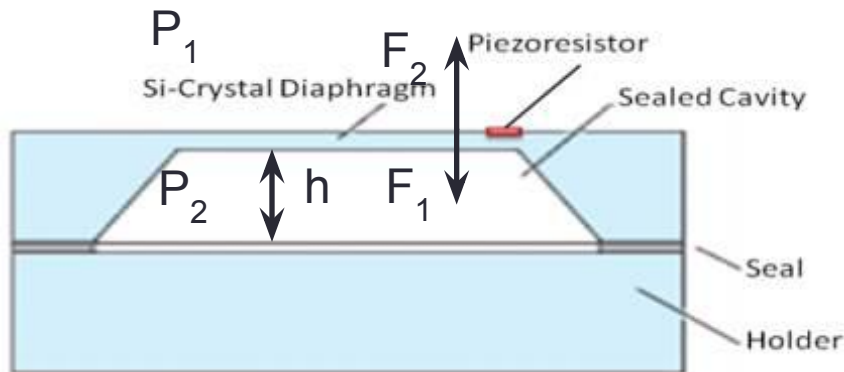


(b)

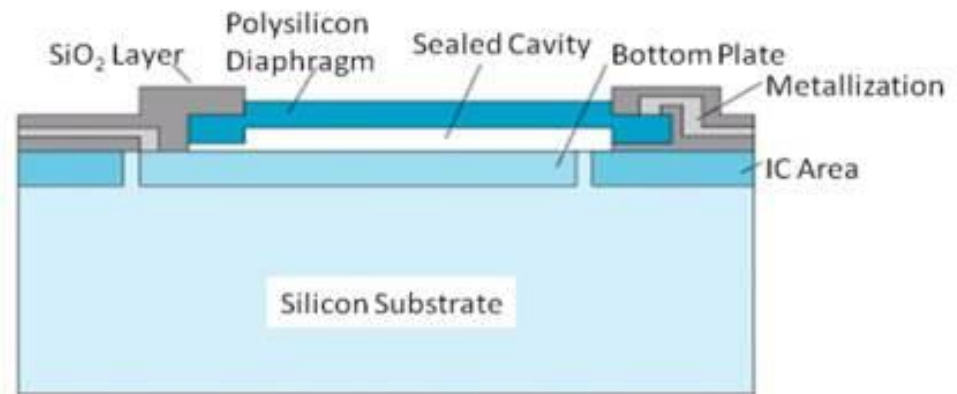


(d)

Датчик давления на основе МЭМС



Датчики давления
пьезорезистивного типа



Датчики давления
емкостного типа

$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

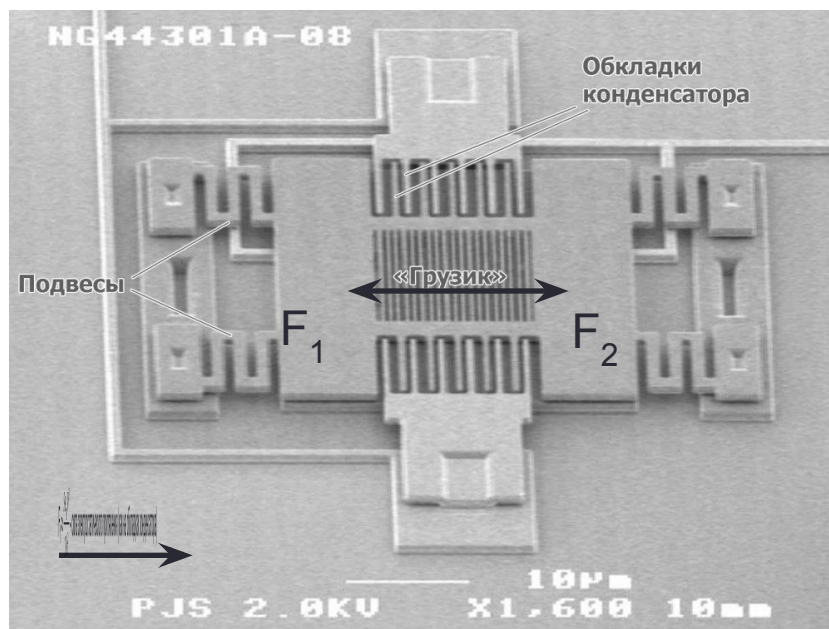
$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

$$(P_1 - P_2) \cdot S = -k \cdot \Delta h$$

$P_1 = P_2 - \frac{k \cdot \Delta h}{S}$, где P_2, k, S - известные и специфичные для датчика величины

$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

Акселерометры и гироскопы



$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

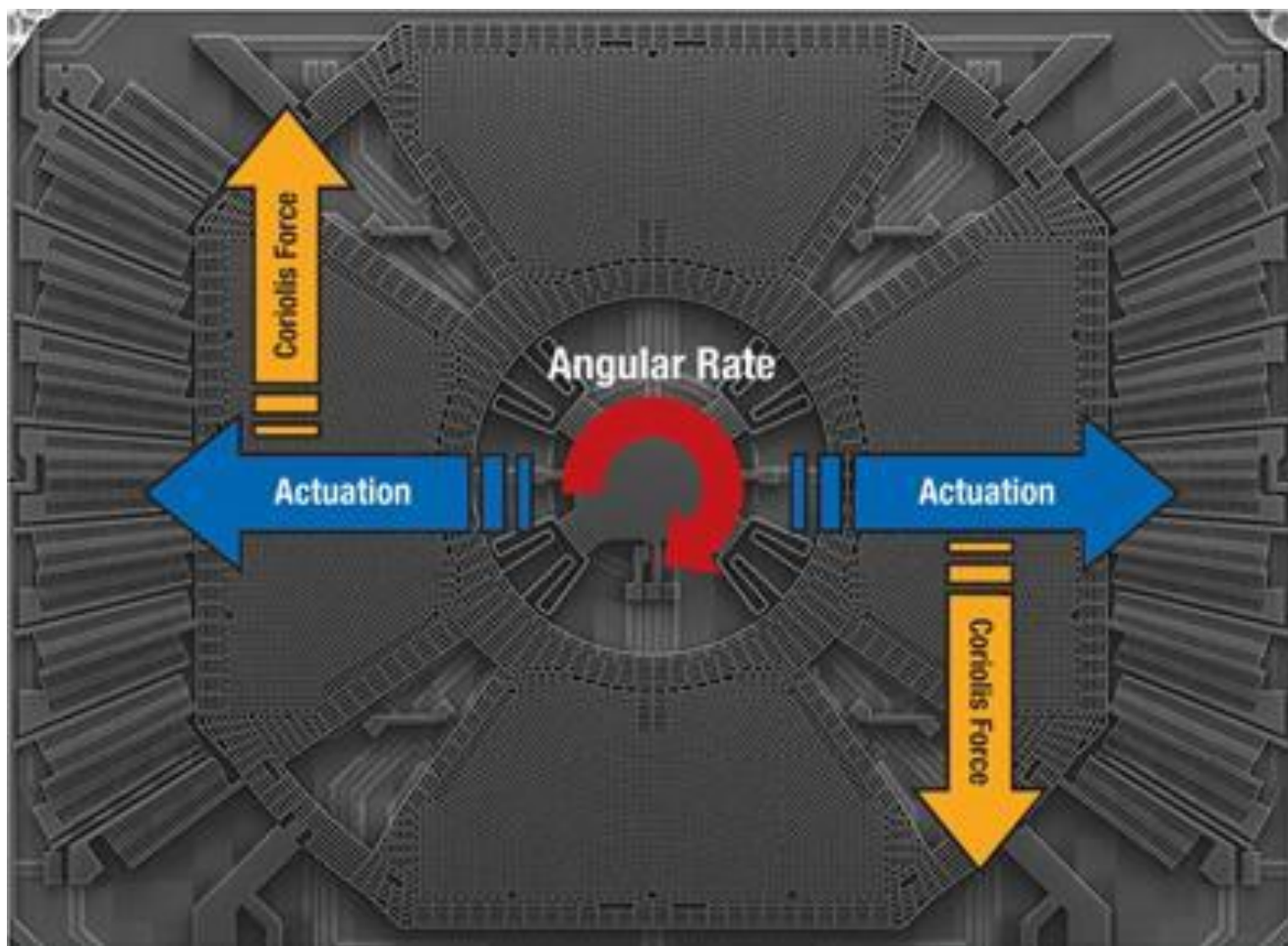
$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

$$a \cdot m = -k \cdot \Delta x$$

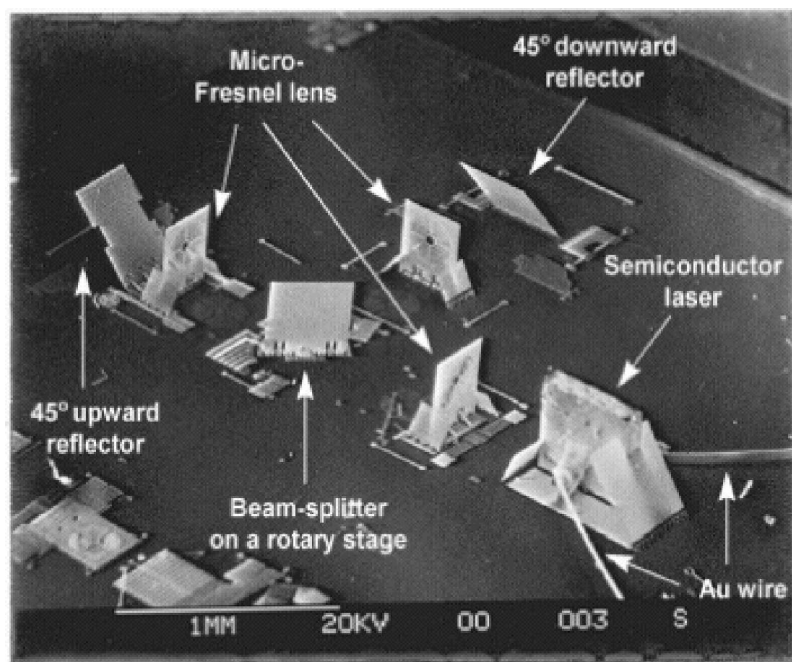
$a = \frac{k \cdot \Delta x}{m}$, где m, k , — известные и специфичные для датчика величины

$F_1 \approx \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot V^2}{2 \cdot h^2}$ - сила электростатического притяжения (как на обкладках конденсатора)

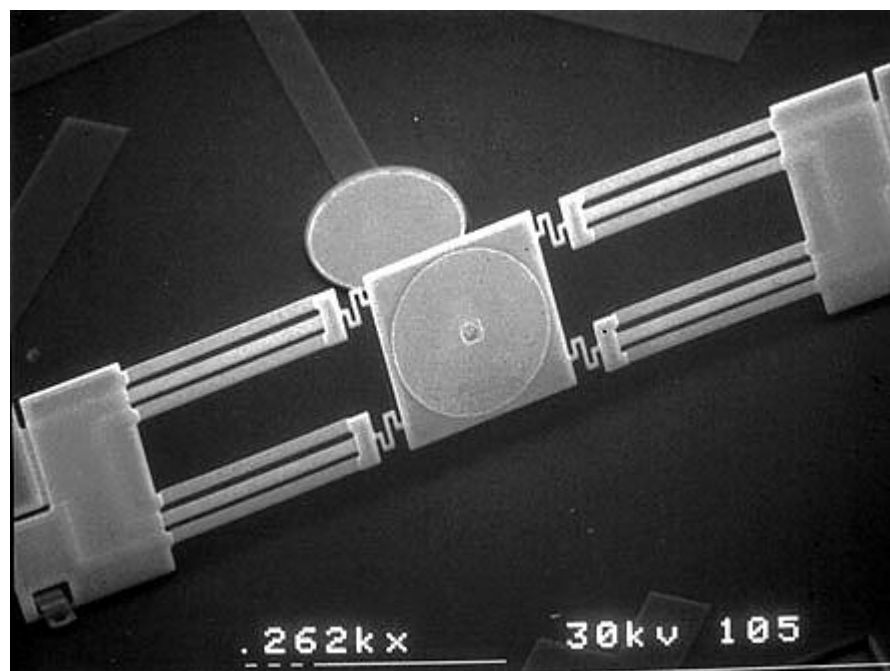
Акселерометры и гироскопы



Оптические МЭМС



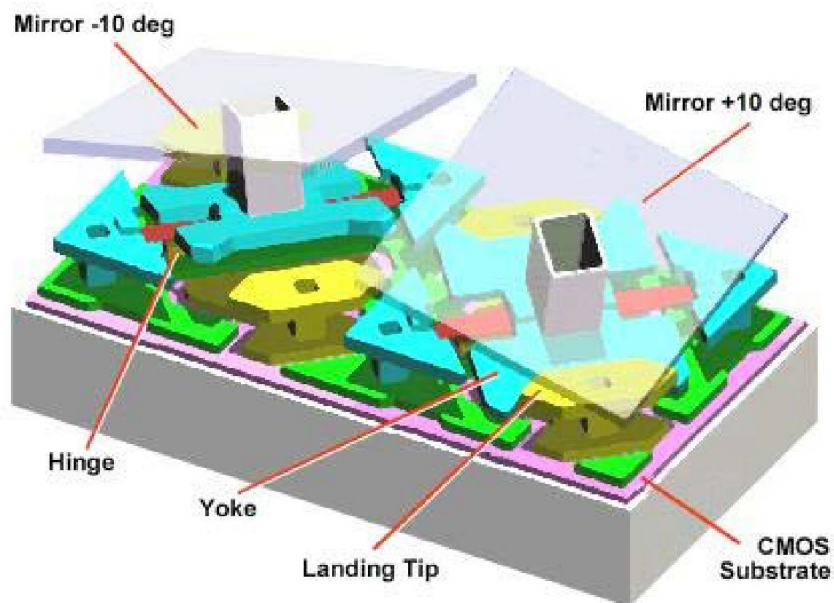
Элементы МОЭМС: зеркала, призмы, линзы



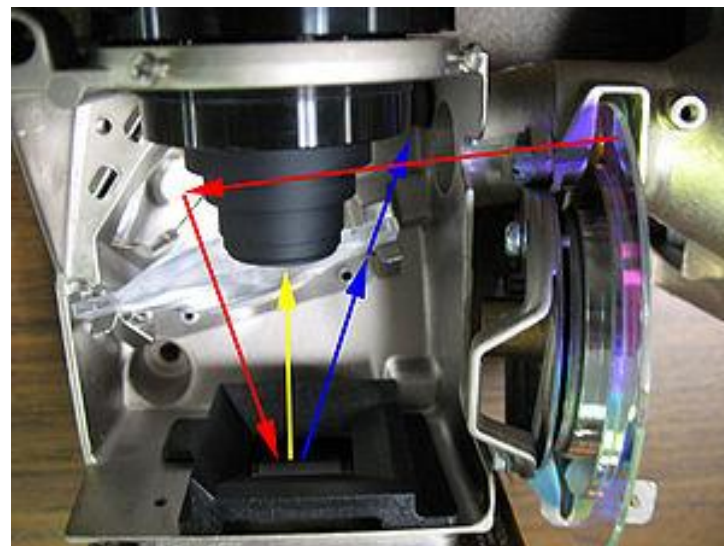
Электростатически управляемое микрозеркало

Оптические МЭМС: DLP

DLP (Digital Light Processing) - технология, используемая во многих проекторах

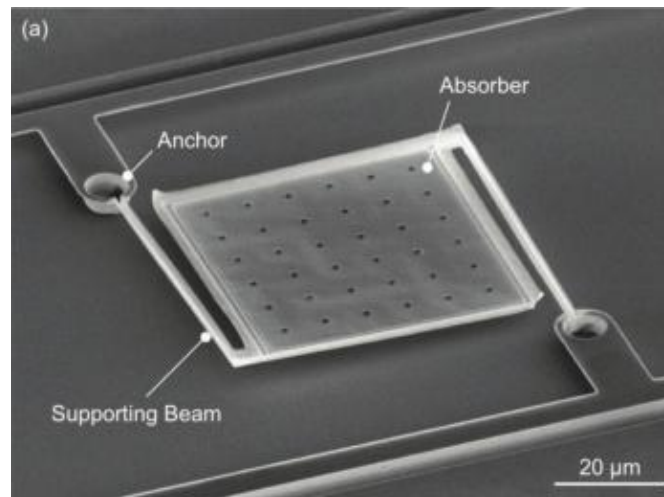
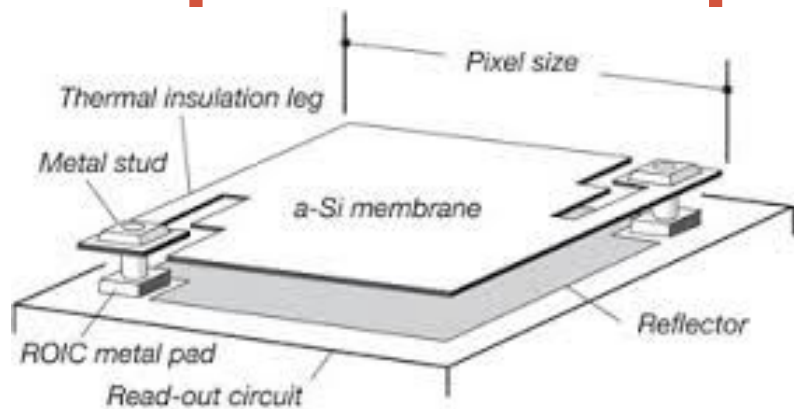


Устройство отклоняющих зеркал



Красной стрелкой показан путь луча света от лампы к матрице, через диск светофильтров, зеркало и линзу. Далее луч отражается либо в объектив (жёлтая стрелка), либо на радиатор (синяя стрелка).

Оптические МЭМС: микроболометры



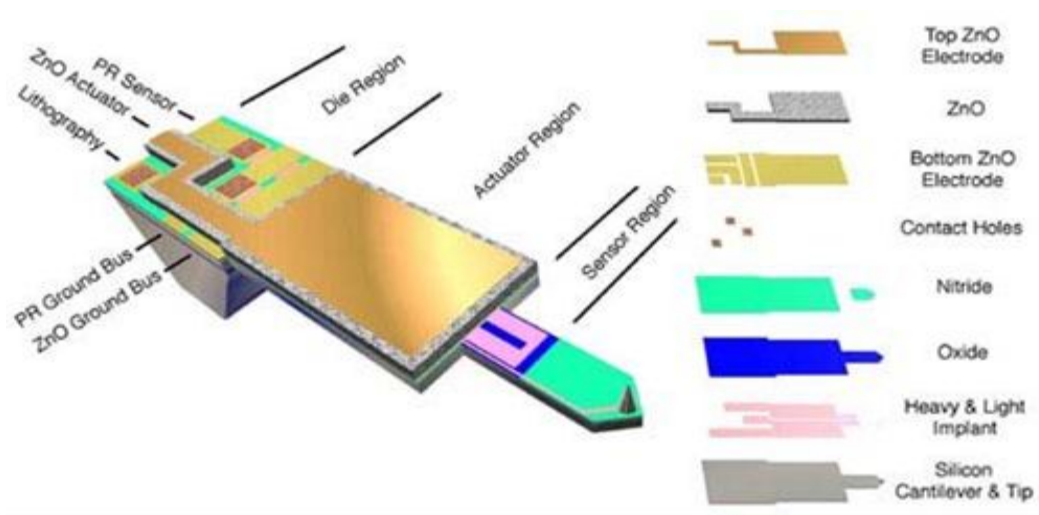
Инфракрасное излучение пройдя сквозь систему линз попадает на поглощающий элемент, нагревая его. Рядом с этим элементов находится терморезистивная пленка, меняющее свое сопротивление от нагрева. Так как температурные коэффициент изменения сопротивления при комнатной температуре невелик (порядка 2% на градус для диоксида ванадия)

Исполнительные механизмы МЭМС

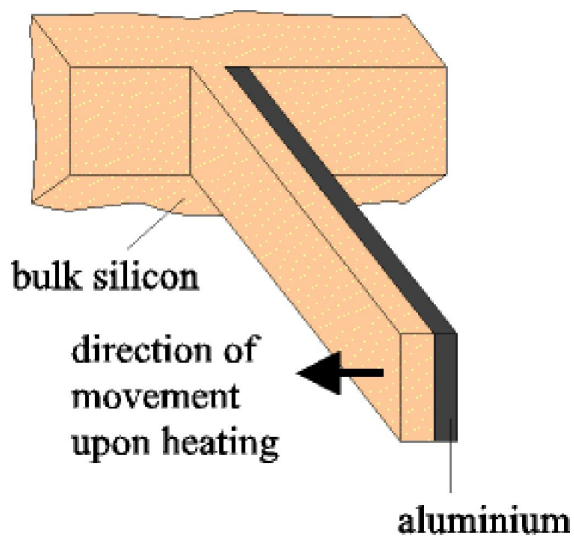
В исполнительных механизмах на основе МЭМС технологий обычно задействуются следующие компоненты:

1. Элементы на основе обратного пьезоэлектрического эффекта – можно получать большие величины силы, но величина смещения мала. Требуется высоких электрических напряжений;
2. Биморфные элементы на основе двух материалов с разным температурным коэффициентом расширения. Можно получать большие величины силы и смещения, процесс происходит медленно и им сложно управлять;
3. Электростатические элементы, работающие за счет электростатического притяжения и отталкивания между обкладками конденсатора. Небольшие величины силы и смещения, легко изготовить, требуются большие значения электрического напряжения;
4. Элементы на основе магнитных катушек. Слабые величины силы, сложно изготовить;

Исполнительные механизмы МЭМС

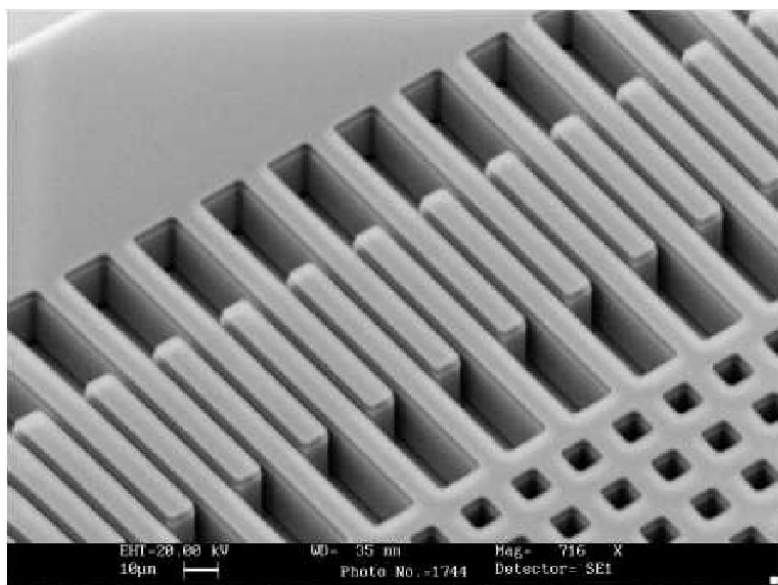


Пьезоакерамический элемент сканера атомно-силового микроскопа

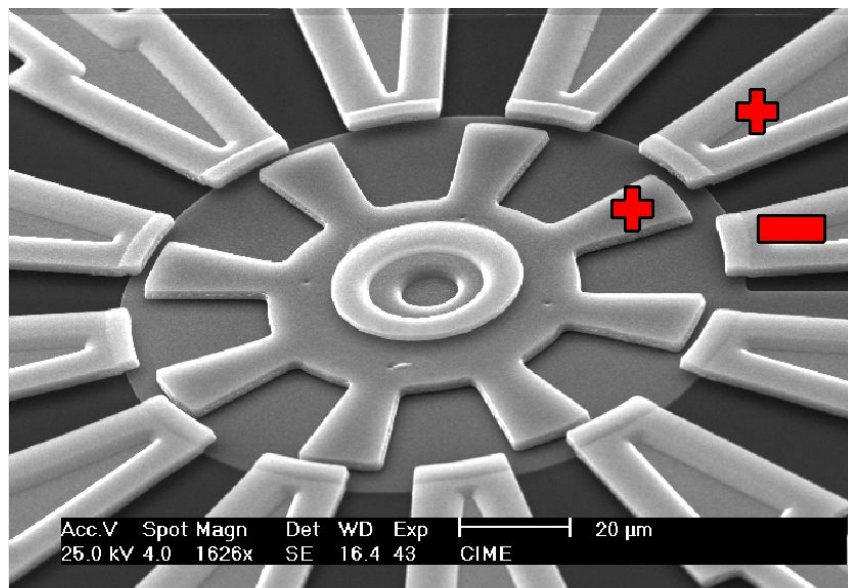


Биморфный (Si - Al) элемент. Стрелкой показано направление изгиба при его нагреве

Исполнительные механизмы МЭМС



*Электростатические актуатор
линейного движения*



*Электростатические актуатор
углового движения*

Список литературы

1. “ВЧ МЭМС и их применение” Варадан В., Виной К., Джозе К., Техносфера, 2004.
2. “Электромеханические микроустройства”, Н. Мухуров, Г. Ефремов, Litres, 2014.
3. MEMS and MOEMS Technology and Applications, P. Rai-Choudhury, SPIE Press, 2000.
4. MEMS: Introduction and Fundamentals, M. Gad-el-Hak, CRC Press, 2005.
5. An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering, N. Maluf, 2000.